解説 高フラックス偏光ガンマ線源のデルブリュック散乱による 量子電磁力学の検証

Delbrück Scattering by High Flux Polarized Gamma-Ray Sources to Test QED

ジェームズ・ケビン・コーガ,早川岳人 James Kevin KOGA and HAYAKAWA Takehito 量子科学技術研究開発機構 (原稿受付: 20121年9月22日)

ペタワット級の超高出力レーザーが世界中で稼働ないし建設中である.これらのレーザーはプラズマとの相 互作用を通じて,高エネルギーの電子,陽子, γ線を生成でき,また超高輝度な直線偏光 γ線の生成が理論的に予 測されている.このような γ線源は,光子と電子の相互作用を記述する量子電磁気学(QED)の研究にも利用で きる.QEDは最低次の過程については実験的に検証されているが,高次の過程はほとんど検証されていない. QEDの高次の過程の一つが,光子が原子核が形成するクーロン場によって弾性散乱するデルブリュック散乱であ る.最近,我々は直線偏光 γ線を用いることでデルブリュック散乱の高精度な測定が可能であることを理論的に 発見した.本記事では,QEDの高次の効果,高輝度 γ線の生成,デルブリュック散乱断面積を計算するための数 値計算技術について解説する.

Keywords:

ultra-high power lasers, gamma rays, nonlinear quantum electrodynamics

1. はじめに

近年、標準模型(SM)物理を超える新しい物理の探索 が、多くの研究グループによって活発に行われている.こ うした多くの探索は、例えばミューオンの異常磁気モーメ ントのような SM 物理からの逸脱を探すための高精度実験 によって行われている[1]. その中でも特に注目されてい る一つが、量子電磁力学(QED)の高次の補正である. QED の最低次の摂動計算は実験と高い精度で一致するこ とがわかっているが、QED をさらに確認するためには、高 次の補正と比較する必要がある.そのような QED の本質 的な高次の補正の1つがデルブリュック散乱である[2,3]. デルブリュック散乱の検証には,現在稼働中の高輝度γ線 装置[4]や、近い将来稼働予定の高輝度な装置[5-8]を用い ることができる. さらに、超高強度レーザーはプラズマと 相互作用によって高エネルギーの電子やγ線の発生源とな る[9-11]. このような光源を用いればデルブリュック散乱 を高精度に測定することができ,SM を超える物理の探索 が可能になることを紹介する. そのため、 デルブリュック 散乱,超高出力レーザーによる高フラックスγ線生成,デ ルブリュック散乱の計算方法について説明し、計算結果か ら高精度な測定が可能であることを示し、実験の実現性を 考慮した上で結論を述べる.

2. デルブリュック散乱とは

QEDにおける高次の摂動の一つが, 電磁場によって引き

Kansai Photon Science Institute, National Institutes for Quantum Science and Technology, Kizugawa, KYOTO 619-0215, Japan

corresponding author's e-mail: koga.james@qst.go.jp

起こされる仮想電子-陽電子に基づく真空の偏極である [12].図1は,QEDの光子と電磁場の相互作用に関するい くつかの高次摂動の,それぞれの最低次の過程を模式的に 示したものである.これらの高次摂動は(a)光子 - 光子散 乱,(b)光子分裂,(c)光子合体,(d)デルブリュック散乱 である[12].光子 - 光子散乱では光子と光子が散乱する. 光子分裂では電磁場と相互作用した光子が2個の光子に分 裂する.光子合体では電磁場と相互作用した2個の光子が



1個の光子に合体する. デルブリュック散乱については後 で述べる.これらの高次摂動は純粋に量子力学的な過程で あり, 古典電磁気学のマクスウェル方程式では発生しない 現象である.これらは20世紀初頭から実験的な検証が試み られてきたが、優れた実験結果が報告されるようになった のは最近になってからである. 2019年に CERN の大型ハド ロン衝突型加速器 (LHC) の Pb+Pb 衝突実験において, 急 速に接近する荷電粒子のクーロン場を担う仮想光子の散乱 断面積が測定された.しかし、これは実在光子の散乱では なく,また断面積が極めて小さいため実験の不確かさが大 きい[13,14]. さらに、X線自由電子レーザーのX線を互い に散乱させることで、実在光子 - 光子散乱断面積の測定が 試みられているが、これまでのところ上限値しか測定され ていない[15]. 光子分裂については、レーザーコンプトン 散乱 (LCS) γ線を用いた測定が2002年に1 例報告されてい るが,その不確かさは大きい[16]. これらの QED の高次 過程の中でも,原子核のクーロン場によるγ線の弾性散乱 であるデルブリュック散乱は、散乱振幅が散乱物質の原子 番号Zに対してZ⁴に比例して急激に増加するため,非常に 良く実験されてきた[2,3]. しかし, 原子からのγ線の弾性 散乱はデルブリュック散乱だけではない. そのため, 弾性 散乱の反応断面積は4つの異なる過程、すなわちレイリー 散乱,核トムソン散乱,原子核の巨大双極子共鳴散乱,デ ルブリュック散乱の量子力学的な干渉を受けた和である [2,3]. そのため従来の実験ではデルブリュック散乱の振 幅のみを計測することが原理的にできなかった. これらに ついては第4節で詳しく説明する.第5節では,我々の主 要な研究成果である直線偏光したγ線ビーム[17]を用いた 場合, 散乱角, 光子の偏光, エネルギーを選択することに よって他の3つの弾性散乱の過程からほぼ独立して、 デル ブリュック散乱の振幅のみを測定できることを説明する. したがって,高フラックスのγ線源を用いれば,デルブ リュック散乱の精密な測定が可能である.

レーザーコンプトン散乱による高輝度な直線 偏光 γ 線生成

現在稼働中のLCS ガンマ線源は,高いフラックスと高い 直線偏光度を持ち高精度の測定が可能である.また,より 高輝度なLCSy 線源も計画されている.LCSy 線は,高エネ ルギーの電子ビームにレーザー光を衝突させ,逆コンプト ン散乱によってy 線を発生させるものである.図2は,エ



ネルギー Ee を持つ電子がエネルギー E₁の入射光子と衝突 し、エネルギー E₂の散乱光子が発生するLCSを模式的に示 している[7]. 散乱光子のエネルギーは次式で与えられる.

$$\epsilon_2 = \epsilon_1 \frac{1 - \beta \cos \theta_1}{1 - \beta \cos \theta_2 + \left(\frac{\epsilon_1}{\gamma_e}\right)(1 - \cos \theta)}$$
(1)

ここで、 $\gamma_{e} = \frac{E_{e}}{m_{e}c^{2}}, \epsilon_{1} = \frac{E_{1}}{m_{e}c^{2}}, \epsilon_{2} = \frac{E_{2}}{m_{e}c^{2}}$ であり、 v_{e} は電子の速度、 $\beta = \frac{v_{e}}{c}$ は電子の相対論的 γ 係数である.入射

電子,入射光子,散乱光子のエネルギーは電子の静止質量 m_ec^2 で規格化されている. θ_1 , $\theta_2 \geq \theta$ は,それぞれ入射光 子と電子,散乱光子と電子,散乱光子と入射光子の間の角 度である.正面衝突の場合,散乱光子のエネルギーは 約 $4\gamma_e^2$ 倍になる.100~1000 MeVのエネルギーを持つ電子 に散乱させることで,可視光領域のエネルギーを持つ電子 に散乱させることで,可視光領域のエネルギーを持つしー ザー光子はMeV領域にエネルギーを上げることができる. 入射レーザーが直線偏光している場合,すなわち入射光子 が偏光している場合, $\gamma_e\epsilon_1 \ll 1$ を満たす場合には散乱後も 偏光が維持される[7].したがって,直線偏光のレーザーか ら直線偏光 γ 線を生成できる.このような高フラックス[5]や 超高フラックス[8]の施設が近々稼働し,高い偏光度を持 つ γ 線によるデルブリュック散乱の精密測定が可能になる.

超高出力のペタワット級やエクサワット級のレーザーが 世界中で建設され,また計画されている[18].このような レーザーが十分に高い強度で固体ターゲットに集光した場 合,シミュレーション計算によればレーザーのエネルギー の大部分がガンマ線に変換される結果が出ている[19,20]. ターゲットの前面で発生するプリプラズマで発生する非線 形トムソン散乱とコンプトン散乱に起因することが示され ている[21].ガンマ線のエネルギー幅は広いが,ほとんど の高エネルギー光子はレーザーの入射方向とほぼ180°逆向 きに放出されることがわかっている[21].また,超高出力 レーザーを用いているが,別のγ線発生原理に基づく超高 出力ガンマ線源も提案されている[22-24].したがって,プ ラズマと相互作用する超高強度レーザーは,デルブリュッ ク散乱の精密測定に有用な高フラックスの高エネルギーガ ンマ線源となる可能性がある.

デルブリュック散乱の反応断面積を数値計算 するための手法

第2節で述べたように、原子からの光子の弾性散乱には 4種類の過程があり[2,3],これらは量子力学的な干渉を 引き起こす.そのため、実験によってγ線の弾性散乱の全 反応断面積の計測を行った場合、測定値からデルブリュッ ク散乱の微分断面積を求めるためには、他の過程を計算し て補正する必要がある.弾性散乱の全微分反応断面積は次 の式で表すことができる[25].

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\perp,\parallel}}{\mathrm{d}\Omega} = r_{\mathrm{e}}^2 |A_{\perp,\parallel}|^2 \tag{2}$$

ここで||と」はそれぞれ光子の偏極が散乱平面に対して平

Commentary

行と垂直を示す. $r_{e} \equiv \frac{e^{2}}{m_{e}c^{2}}$ は電子の古典的半径を, e は電子の電荷を示す.さらに、散乱振幅 $A_{\perp,\parallel}$ は

$$A_{\perp,\parallel} = A_{\perp,\parallel}^{\mathrm{T}} + A_{\perp,\parallel}^{\mathrm{GDR}} + A_{\perp,\parallel}^{\mathrm{R}} + A_{\perp,\parallel}^{\mathrm{D}}, \qquad (3)$$

と記述でき,ここで T, GDR, R と D はそれぞれ, 核トム ソン散乱, 原子核の巨大双極子共鳴, レイリー散乱, デル ブリュック散乱を示す. 光子と原子核との間で発生する原 子核トムソン散乱 (T) は次の式で記述できる[25].

$$A_{\perp}^{\rm T} = -\frac{Z^2 e^2 m_{\rm e}}{M c^2} \left(1 - \frac{1}{3} k^2 \langle r^2 \rangle \right), \tag{4}$$

$$A_{\parallel}^{\mathrm{T}} = A_{\perp}^{\mathrm{T}} \cos\theta \tag{5}$$

ここで M は原子核の質量, k は入射光子の波ベクトル \vec{k} の波数であり, r は原子核の荷電半径, θ は図3に示すように散乱角度を示す.原子核の巨大双極子共鳴(GDR)は、最も簡単な描像では、原子核における陽子の集団に対する中性子の集団の振動で記述できる[26].その場合GDRの散乱振幅は1つないし2つのローレンス関数で次の式のように近似できる[25].

$$A_{\perp}^{\rm GDR} = \frac{E^2}{4\pi \hbar c r_{\rm e}} \sum_{j=1}^2 \sigma_j \Gamma_j \frac{E_j^2 - E^2}{(E_j^2 - E^2)^2 + E^2 \Gamma_j^2}, \quad (6)$$

$$A_{\parallel}^{\rm GDR} = A_{\perp}^{\rm GDR} \cos\theta \tag{7}$$

ここで*E*は γ 線のエネルギー, (σ_j , E_j , Γ_j)は関数のパラ メータである.本研究では、パラメータの値はリファレン ス入力パラメータ・ライブラリー・データベース (RIPL-3)から採用した[27,28].次に、レイリー散乱は、原子の 束縛電子による光子の散乱であり、相対論的な 2 次の S 行列と形式因子を用いて計算することができる[29].この 計算には、核トムソン散乱やGDRの散乱振幅に対する(4) ~(7)のような簡単な式はない.そのため、レイリー散乱 (*R*)の振幅 $A_{\perp,\parallel}^{R}$ の値は、既に計算されている RTAB デー タベース[29]の値を利用するか、Lynn Kissel博士[30]が 開発したコード ENTING を用いて計算する必要がある. Kissel博士は10年以上前に引退していたが、問い合わせた ところ快くコードのコピーを譲ってくれた.**図4**のファイン マンダイヤグラムに示した最低次のデルブリュック散乱の散



図3 散乱面



図4 kとKはそれぞれ入射光子と出射光子の4ベクトル運動量、 iとjはそれぞれの偏光方向. Δ = K'-kは運動量の移動を表 す.×は原子核のクーロン場を表し、qは場の運動量を表 す.

乱振幅は, 摂動論的QEDを用いて計算できる. 過去の研究 [31-33]では, 散乱振幅の実部および虚部を3次元および 4次元の積分による近似式で得られている. その微分散乱 断面積は, 光子の右巻きと左巻きに対応する偏光(それぞ れ, +と-の添え字で表示)で記述される.

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{++,+-}}{\mathrm{d}\Omega} = (Z\alpha)^4 r_{\mathrm{e}}^2 |a_{++,+-}|^2, \qquad (8)$$

ここで $a \equiv \frac{e^2}{hc} \sim \frac{1}{137}$ は微細構造係数であり、散乱振幅 $a_{++} \ge a_{+-}$ はそれぞれ光子の偏光が散乱の前後で維持され た場合と変更された場合を示す.散乱平面に対して垂直な 方向と平行な方向に対する振幅は、[33]より次の式から得 られる.

$$A_{\perp}^{\rm D} = a_{++} - a_{+-}, \qquad (9)$$

$$A_{\parallel}^{\rm D} = a_{++} + a_{+-} \tag{10}$$

a++ と a+- の実部と虚部を記述する式は[31-33]で提案され,[17]で検証された.(9)と(10)式のより詳細な式は [31-33]に記述されている.我々は,これらの式の値をモン テ・カルロ積分ルーティン[34]を用いて数値計算すること で,デルブリュック散乱の反応断面積を求めた.

5.計算結果と議論

最低次のデルブリュック散乱振幅は,式(8)に見られる ように,散乱物質の原子番号Zに対して(Za)²に比例して増 加する.再低次より一つ高い高次の寄与は,a(Za)⁴に比例 する.また,光子のエネルギーや散乱角度の増加とともに 増加する[3].残念ながら,さらに一つ高次の寄与は,ま だ理論計算されていないため全振幅を計算できない.その ため,全振幅は有限原子核サイズの補正を用いて解析的に 定式化されたが,その式を用いた数値計算は,1990年代の 計算機では非常に長い時間が必要であり,非常に少ない実 験データのみを考慮した不完全な計算結果となった[35]. なお,現在の計算機でも一定の時間がかかる.さらに,式

の項の数が非常に多いため、もう一つ高次の寄与を計算す ることができなかった[36]. そこで、これらの高次の寄与 (すなわち, クーロン補正) が小さくなるような Z, 光子エ ネルギー、散乱角の値を選んだ後に計算を行う必要があ る. Zが小さくなるほど高次の寄与は小さくなり、Z<50 の散乱物質ではその寄与が5%以下まで下がることが判明 している[37].またエネルギーが下がるほど高次の寄与が 小さくなるが、U (Z = 92)の散乱試料においても、2 MeV 以下のγ線エネルギーでは、実験の再現に最低次の散乱振 幅を考慮すれば十分であることが示されている(文献[37] に引用されている文献を参照). 1.115 MeV 以下の光子エ ネルギーでは、W (Z = 74) と Pb (Z = 82) の散乱試料に おいて、最低次の寄与が約5%の実験的不確かさで一致す ることが実験で確認されている[38].しかし, 2.754 MeV のエネルギーでは、Pb, Bi, Th, Uの散乱試料では、計測 された反応断面積と最低次の寄与のみの計算結果との差が 2倍にもなっている[38].本研究では、上記の制約を考慮 して, 散乱物質には Sn (Z = 50) を選択し, γ線のエネル ギーは 1.050~1.150 MeV の範囲として計算を行った. 下限 値はデルブリュック散乱の近似式が適用可能な下限エネル ギーの 1.022 MeV 以上[31-33]になるように選択した.な お, RTAB データベース[30] で利用可能なエネルギーでも ある. 1990年代までの実験では、高輝度γ線源として原子 炉で生成した高線量の放射性同位体が主に用いられてい た.一方, LCSy 線では直線偏光が可能であることに着目 し,直線偏光に対する依存性を特に重要視した.

式(6)の GDR 散乱振幅については, RIPL-3 データベー ス[27,28]から, Sn の同位体の中で最も同位体組成の多 い¹²⁰Sn のパラメータを用いた. j=1 は式(6)の和の中で 唯一有効な項であり, そのパラメータはE=15.37 MeV, $\sigma_1=$ 284.1 mb (mb=10⁻²⁷ cm²), $\Gamma_1=5.08$ MeV である[27]. レ イリー散乱 (R) 振幅は, RTABデータベース[30]と同じパ ラメータを用いて ENTING で新たに計算した.ここで, 10 個の内殻電子の寄与を相対論的 2 次の S 行列を用いて計算 し, 40個の外殻電子の寄与を形状因子[29]を用いて計算し た.T 振幅は ENTING[30]で計算した.

図5は、1.10 MeV の γ 線、散乱面内の散乱角 40° $\leq \theta \leq 120^{\circ}$ におけるデルブリュック散乱(D)およびそ れ以外の散乱過程の和(R+T+GDR)の微分断面積 do_{ll}/dΩ の計算結果を示している([17]の図4から引用). R+T+GDRの do_{ll}/dΩ は70°付近で急激に落ち込み最小と なる.R+T+GDRの散乱振幅の実部は70°付近で負の値か ら正になる一方、虚部は実部に比べて小さいことがわかっ た[17].反応断面積は振幅の2乗に比例するため、70°近 傍に最小値が出現する.式(5)と(7)からわかるように、 TとGDR は $\theta = 90^{\circ}$ で振幅が0になるが、Rからの寄与は 谷の位置をより小さい角度にシフトさせる[17].

この結果は,直線偏光した光子を十分に低いエネルギー で十分に小さい原子電荷の試料に照射し,偏光面に平行な 面で散乱を計測すれば,デルブリュック散乱の高次の効果 が十分に小さい条件で反応断面積を計測できることを示し ている.すなわち,これらの光子の弾性散乱に対する真空





の寄与(デルブリュック散乱)をほぼ分離し,正確に測定 できることを示している[17].

6. 結論

偏光性の高いγ線を物質から散乱させることで,真空の 偏極を測定するデルブリュック散乱の高精度な測定値を得 ることができる[17]. このような高フラックス高偏光ガン マ線源は現在も稼働中であり[4],また近い将来により高 輝度な施設も稼働予定であり[5-8], 実験が期待される. ま た,ペタワットやエクサワットの超高出力レーザーが世界 中で建設され、また計画されている[18]. これらのレー ザーは、十分に高い強度で固体ターゲットに集光すると、 超高輝度のγ線を発生させることができる[19,20].別の 原理に基づく超高出力レーザーによる超高出力γ線生成も 提案されている[22-24]. このような高フラックスの偏光 γ線源は, QED の理論的予測からの逸脱の探索に用いるこ とができる. このような高輝度γ線を用いれば、 デルブ リュック散乱の測定を合理的な実験時間で高精度に行うこ とができる.したがって、これらの新しい施設は、物理学 の標準モデルを超える新しい物理学の探索に用いることが できる.

参 考 文 献

- [1] B. Abi et al., Phys. Rev. Lett. 126, 141801 (2021).
- [2] A.I. Milstein and M. Schumacher, Phys. Rep. 243, 183 (1994).
- [3] M. Schumacher, Rad. Phys. Chem. 56, 101 (1999).
- [4] V.N. Litvinenko et al., Phys. Rev. Lett. 78, 4569 (1997).
- [5] K. Dupraz *et al.*, Phys. Rev. ST Accel. Beams **17**, 033501 (2014).
- [6] F. Albert *et al.*, Phys. Rev. ST Accel. Beams 14, 050703 (2011).
- [7] R. Hajima and M. Fujiwara, Phys. Rev. Accel. Beams 19, 020702 (2016).
- [8] M.W. Krasny, "The Gamma Factory proposal for CERN," arXiv:1511.07794 [hep-ex].

Commentary

- [9] T. Nakamura et al., Phys. Rev. Lett. 108, 195001 (2012).
- [10] C.P. Ridgers et al., Phys. Rev. Lett. 108, 165006 (2012).
- [11] K.V. Lezhnin et al., Phys. Plasmas 25, 123105 (2018).
- [12] V. Costantini *et al.*, Nuovo Cimento Soc. Ital. Fis. A **2**, 733 (1971).
- [13] G. Aad *et al.*, (ATLAS Collaboration), Phys. Rev. Lett. **123**, 052001 (2019).
- [14] The CMS Collaboration, Phys. Lett. B 797, 134826 (2019).
- [15] T. Yamaji et al., Phys. Lett. B 763, 454 (2016).
- [16] Sh. Zh. Akhmadaliev *et al.*, Phys. Rev. Lett. **89**, 061802 (2002).
- [17] J.K. Koga and T. Hayakawa, Phys. Rev. Lett. 118, 204801 (2017).
- [18] C.N. Danson *et al.*, High Power Laser Sci. Eng. 7, E54 (2019).
- [19] T. Nakamura et al., Phys. Rev. Lett. 108, 195001 (2012).
- [20] C.P. Ridgers et al., Phys. Rev. Lett. 108, 165006 (2012).
- [21] K.V. Lezhnin et al., Phys. Plasmas 25, 123105 (2018).
- [22] J. Magnusson et al., Phys. Rev. Lett. 122, 254801 (2019).



じぇーむず けびん こーが James Kevin Koga

量子科学技術研究開発機構量子ビーム科 学部門関西光科学研究所光量子科学研究 部高強度レーザー科学研究グループ専門 業務員.Ph.D. in Physics (University of

Texas at Austin).非線形量子電気力学,相対論的レーザー・ プラズマ相互作用理論シミュレーションおよび標準模型を超 える物理を中心に研究を行っている.昨年,40年以上ぶりに バイオリンのレッスンを再開しました.

- [23] J. Magnusson et al., Phys. Rev. A 100, 063404 (2019).
- [24] T. Wang et al., Phys. Rev. Appl. 13, 054024 (2020).
- [25] P. Rullhusen et al., Phys. Rev. C 23,1375 (1981).
- [26] B.L. Berman and S.C. Fultz, Rev. Mod. Phys. 47, 713 (1975).
- [27] https://www-nds.iaea.org/RIPL-3/
- [28] R. Capote et al., Nucl. Data Sheets 110, 3107 (2009).
- [29] L. Kissel, Radiat. Phys. Chem. 59, 185 (2000).
- [30] L. Kissel (private communication).
- [31] B. De Tollis and G. Pistoni, Nuovo Cimento Soc. Ital. Fis. A 42, 499 (1977).
- [32] B. De Tollis, M. Lusignoli and G. Pistoni, Nuovo Cimento Soc. Ital. Fis. A 32, 227 (1976).
- [33] B. De Tollis and L. Luminari, Nuovo Cimento Soc. Ital. Fis. A 81, 633 (1984).
- [34] T. Hahn, Comput. Phys. Commun. 207, 341 (2016).
- [35] A. Scherdin et al., Z. Phys. A 353, 273 (1995).
- [36] H. Cheng, E.-C. Tsai and X. Zhu, Phys. Rev. D 26, 908 (1982).
- [37] B. Kasten *et al.*, Phys. Rev. C 33, 1606 (1986).
- [38] B. Kunwar et al., Phys. Rev. A 71, 032724 (2005).



^{はや かわ たけ ひと} 早 川 岳 人

量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科 学部門 東海量子ビーム応用研究センター LCS ガンマ線研究プロジェクト 上席研究 員. 筑波大学 博士 (物理学).宇宙核物理

学,原子核物理学,光核科学などが専門.レーザーコンプトン散乱ガンマ線やレーザー駆動量子ビームを用いた実験から,超新星ニュートリノ原子核反応による宇宙年代学の研究など多様な分野で研究を行う.趣味は山歩き.